

TT 31 N, TD 31 N, DT 31 N

Elektrische Eigenschaften**Electrical properties****Höchstzulässige Werte****Maximum rated values**

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-SpitzenSperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	600, 800 1000, 1200 1400, 1600	V
Vorwärts-StoßspitzenSpannung	non repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$		
Rückwärts-StoßspitzenSpannung	non repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	$t_C = 85^\circ\text{C}$	I_{TRMSM}	75	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_C = 50^\circ\text{C}$	I_{TAVM}	31 48	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \mu\text{s}$ $t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \mu\text{s}$	I_{TSM}	780 680	A
Grenzlastintegral	$\int i^2 dt$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \mu\text{s}$	$\int i^2 dt$	3040 2300	A^2s
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$V_D \leq 67\% V_{DRM}, f_c = 50 \text{ Hz}$ $V_L = 8 \text{ V}, I_{GM} = 0,6 \text{ A}, dI_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	100	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 67\% V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte**Characteristic values**

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, I_T = 150 \text{ A}$	V_T	max.	2,02 V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$V_{T(TO)}$		0,95 V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$	r_T		6,4 mΩ
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}	max.	150 mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}	max.	2,5 V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non trigger current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}	max.	5 mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}	max.	0,2 V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 10 \Omega$	I_H	max.	200 mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 20 \Omega$ $i_{GM} = 0,6 \text{ A}, dI_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 10 \mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	I_L	max.	600 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 0,6 \text{ A}, dI_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$ siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	i_D, i_R	max.	8 mA
Zündverzug	gate controlled delay time		t_{gd}	max.	1,2 μs
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time		t_q	typ.	60 μs
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage		V_{ISOL}		2,5 kV

Thermische Eigenschaften**Thermal properties**

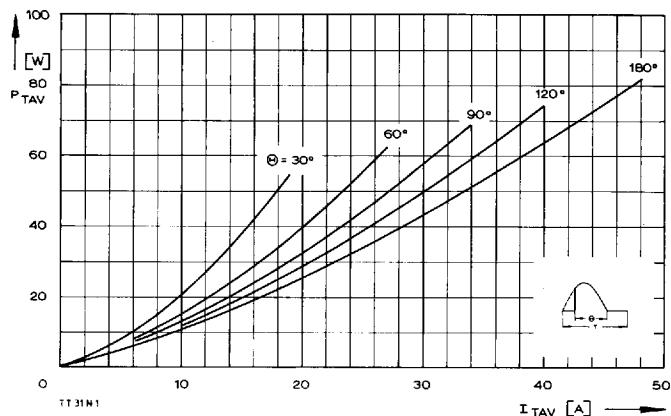
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^\circ\text{el}, \sinus:$ pro Modul/per module DC: pro Zweig/per arm pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thJC}	max.	0,46°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thCK}	max.	0,01°C/W 0,02°C/W
Höchstzul. Sperrschiitttemperatur Betriebstemperatur Lagertemperatur	max. junction temperature operating temperature storage temperature		$t_{vj \max}$ t_{cop} t_{stg}		125°C - 40°C ... +125°C - 40°C ... +125°C

Mechanische Eigenschaften**Mechanical properties**

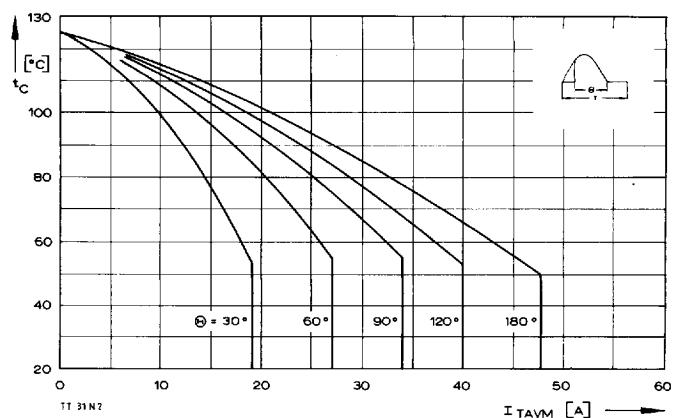
Si-Elemente glaspassiviert, Lötkontakt	Si-pellets glass-passivated, soldered contact			Al_2O_3
Innere Isolation	internal insulation			
Anzugsdrehmomente	tightening torques			
mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance ± 15%	$M1$	4 Nm
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance + 5%/- 10%	$M2$	4 Nm
Gewicht	weight		G	typ. 160 g
Kriechstrecke	creepage distance			12,5 mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$		$5 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$
Maßbild	outline			1

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

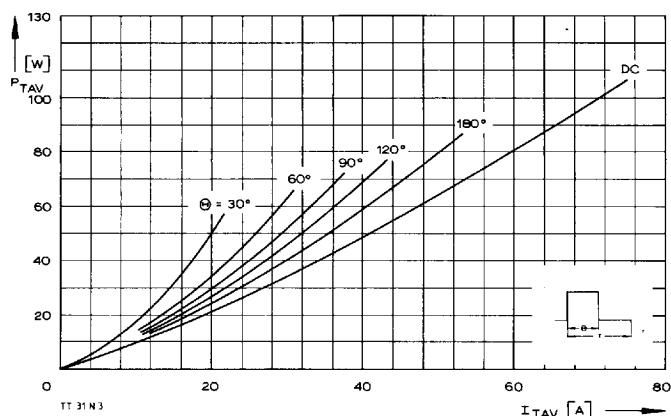
TT 31 N, TD 31 N, DT 31 N



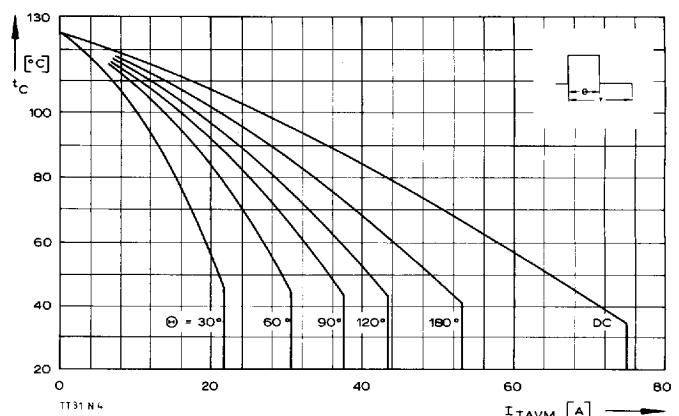
Bild/Fig. 1
Durchlaßverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm P_{TAV}
Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle θ



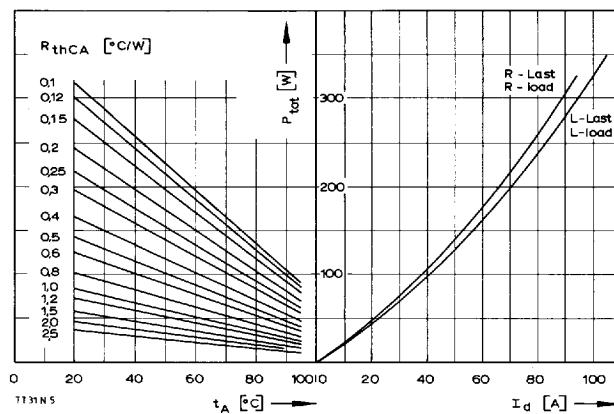
Bild/Fig. 2
Höchstzulässige Gehäusetemperatur t_C in Abhängigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowale case temperature t_C versus current per arm



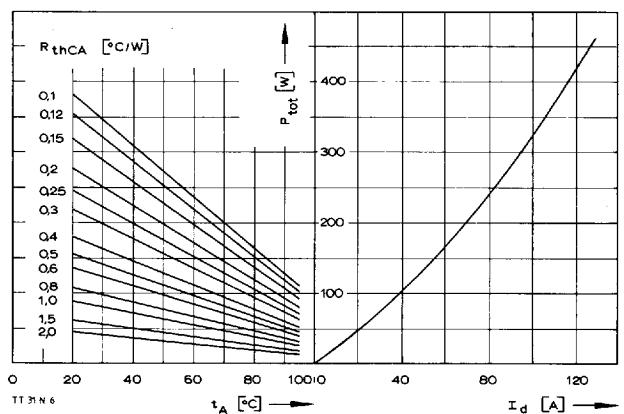
Bild/Fig. 3
Durchlaßverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm P_{TAV}
Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle θ



Bild/Fig. 4
Höchstzulässige Gehäusetemperatur t_C in Abhängigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowale case temperature t_C versus current per arm

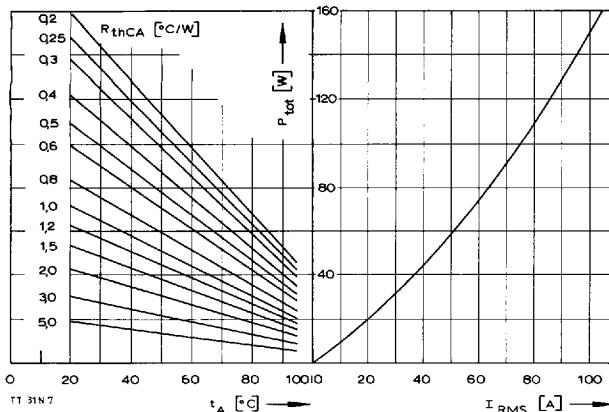


Bild/Fig. 5
B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom I_d in Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur t_A .
Maximum allowable output current I_d versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

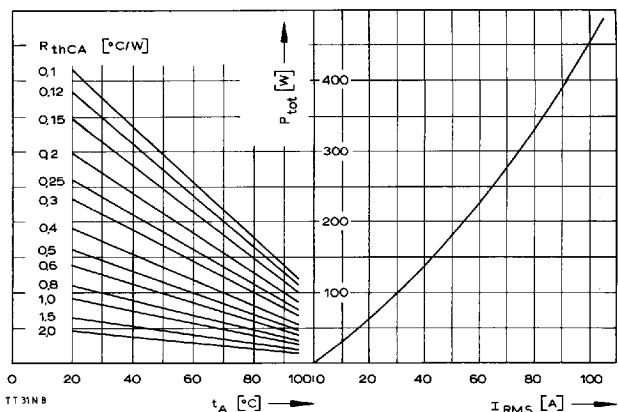


Bild/Fig. 6
B6 – Sechspuls-Brückenschaltung/Six-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom I_d in Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur t_A .
Maximum allowable output current I_d versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

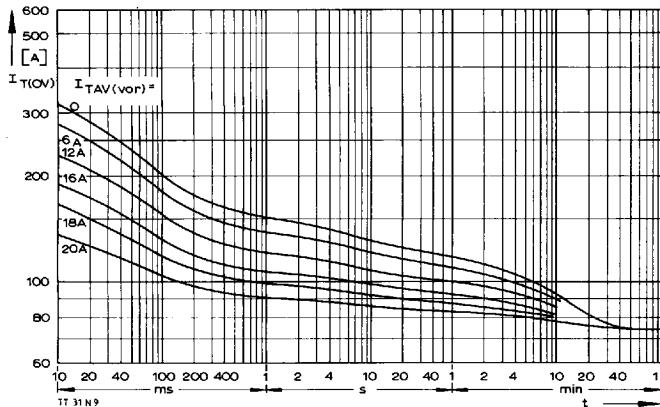
TT 31 N, TD 31 N, DT 31 N



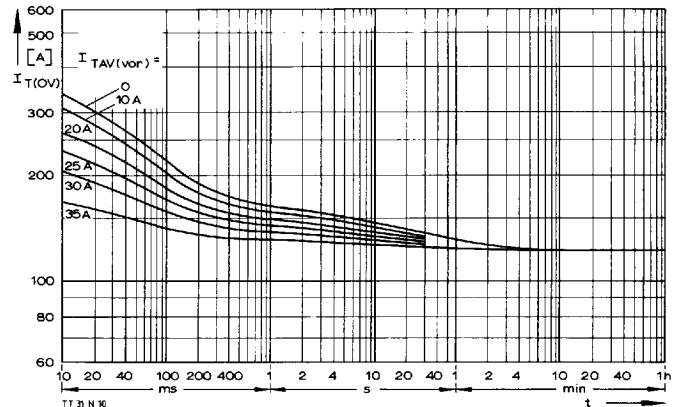
Bild/Fig. 7
W1C – Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Strom I_{RMS} in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur t_A .
Maximum allowable current I_{RMS} versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}



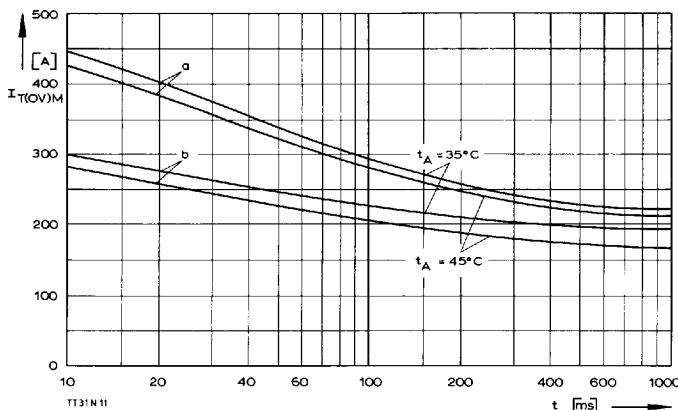
Bild/Fig. 8
W3C – Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Strom je Phase I_{RMS} in Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur t_A .
Maximum allowable current per phase I_{RMS} versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}



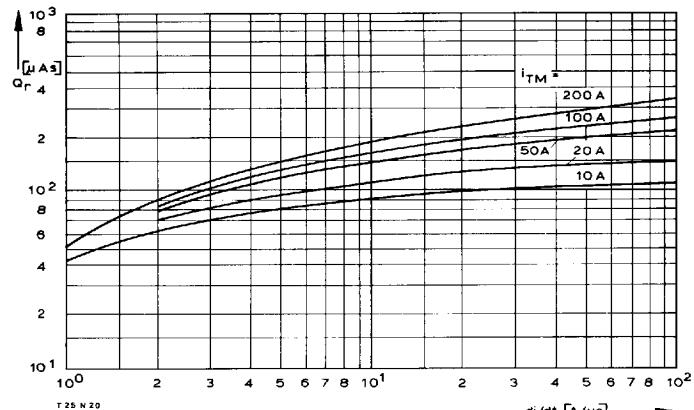
Bild/Fig. 9
B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(OV)}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A = 45^\circ C$, Kühlkörper KP 0,33 S.
Overload on-state current per arm $I_{T(OV)}$ at natural cooling, $t_A = 45^\circ C$,
heat sink type KP 0,33 S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$



Bild/Fig. 10
B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(OV)}$ bei verstärkter Luftkühlung, $t_A = 35^\circ C$, $V_L = 90$ l/s,
Kühlkörper KP 0,33 S.
Overload on-state current per arm $I_{T(OV)}$ at forced cooling, $t_A = 35^\circ C$, $V_L = 90$ l/s,
heat sink type KP 0,33 S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$

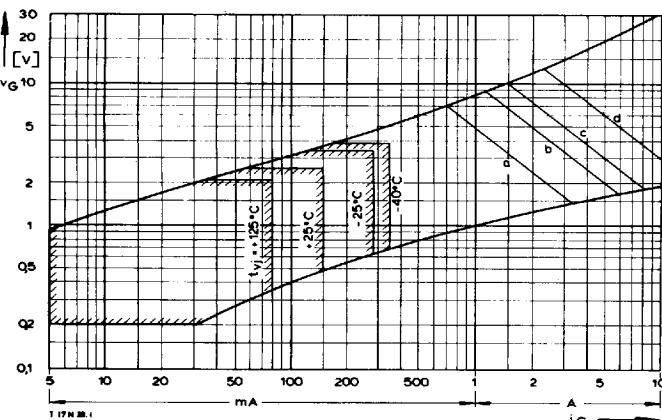


Bild/Fig. 11
Grenzstrom je Zweig $I_{T(OV)M}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A = 45^\circ C$ und verstärkter
Luftkühlung, $t_A = 35^\circ C$, Kühlkörper KP 0,33 S, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
Limiting overload on-state current per arm $I_{T(OV)M}$ at natural ($t_A = 45^\circ C$) and
forced ($t_A = 35^\circ C$) cooling, heat sink type KP 0,33 S, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
a – Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b – Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom i_{TAVM}
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating I_{TAVM} .



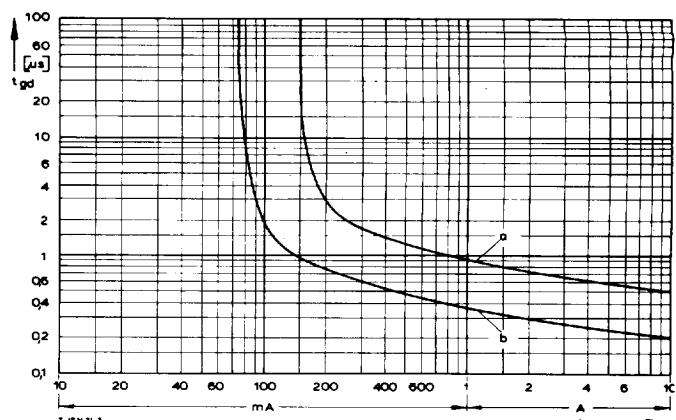
Bild/Fig. 12
Sperrverzögerungsladung Q_r in Abhängigkeit von der abkommunierenden
Stromsteilheit $-di/dt$ bei $t_{vj} = t_{vj \max}$, $V_R = 0.5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
Der angegebene Verlauf ist gültig für 90% aller Elemente.
Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current
 $-di/dt$ at $t_{vj} = t_{vj \max}$, $V_R = 0.5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
These curves are valid for 90% of all devices.
Parameter: Durchlaßstrom i_{TM} /On-state current i_{TM}

TT 31 N, TD 31 N, DT 31 N

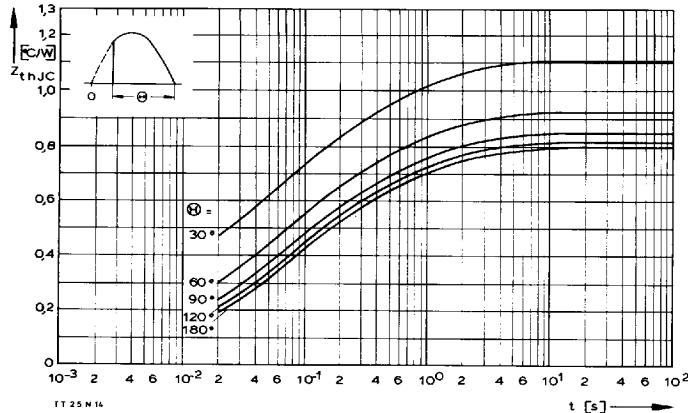


Bild/Fig. 13
Zündbereich und Spitzensteuerleistung bei $V_D = 6$ V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at $V_D = 6$ V.

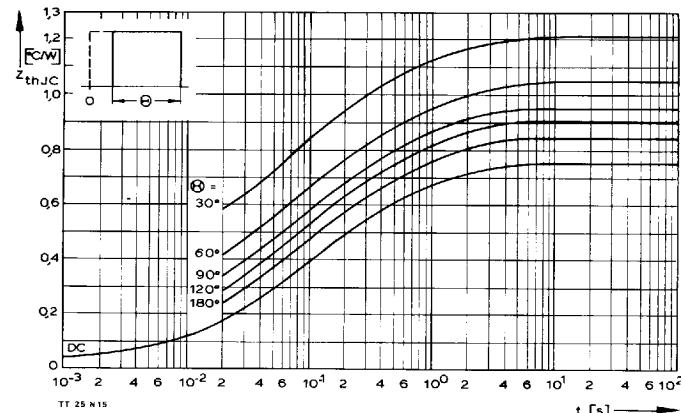
Parameter:	a	b	c	d
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t_g [ms]	10	1	0,5	0,1
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/ Maximum allowable peak gate power [W]	5	10	15	30



Bild/Fig. 14
Zündverzug/Gate controlled delay time t_{gd} .
DIN 41787, $t_a = 1 \mu s$, $t_w = 25^\circ C$.
a – äußerster Verlauf/limiting characteristic
b – typischer Verlauf/typical characteristic



Bild/Fig. 15
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig Z_{thJC} .
Transient thermal impedance per arm Z_{thJC} , junction to case.



Bild/Fig. 16
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig Z_{thJC} .
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Z_{thJC} .

Pos. n	1	2	3	4
R_{thn} [°C/W]	0,0517	0,111	0,162	0,511
τ_n [s]	0,00153	0,00968	0,0501	0,173

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-t/\tau_n})$$

Transienter Wärmewiderstand Z_{thJC} pro Zweig für DC.
Transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC.